

	<h2 style="color: orange;">FDB070AN06A0</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB070AN06A0</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p> <p>Datenblätter:  FDB070AN06A0.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28251 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB070AN06A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	28251 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	175W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB070AN06A0CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	9 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 15A (Ta), 80A (Tc) 175W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta), 80A (Tc)

FDB070AN06A0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB070AN06A0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB070AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB070AN06A0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB070AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>	 <p>FDB0630N1507L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A</p>	 <p>FDB070AN06A0 FAIRCHI FDB070AN06A0 FAIRCHI</p>	 <p>FDB070AN06A0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A TO-263AB</p>
 <p>FDB060AN08A0 FAIRCHI FDB060AN08A0 FAIRCHI</p>	 <p>FDB070AN06_F085 FAIRCHILD FDB070AN06_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB0690N1507L AMI Semiconductor / ON Semiconductor 150V TO263 7L JEDEC GREEN EMC</p>	 <p>FDB0630N1507L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A</p>

FDB070AN06A0 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB070AN06A0 ON Semiconductor	FDB070AN06A0 Datenblatt	FDB070AN06A0-Datenblätter	FDB070AN06A0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB070AN06A0
FDB070AN06A0 Electronic	FDB070AN06A0-Komponenten	FDB070AN06A0-Verteiler	FDB070AN06A0-Bild	FDB070AN06A0-Teil
FDB070AN06A0 Preis	FDB070AN06A0 Hersteller	FDB070AN06A0 Bild	FDB070AN06A0 Aktie	FDB070AN06A0 Inventar
FDB070AN06A0 Neu	FDB070AN06A0 Original	FDB070AN06A0 garantiert	FDB070AN06A0 RFQ	FDB070AN06A0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited